

ÉPITAXIE PAR JET CHIMIQUE

FABRICANT : VG Semicon

MODÈLE : VG90H

Seul bâti CBE en occident ayant une capacité 100 mm industrielle :

- Taille d'échantillons : 10 mm à 100 mm
- Uniformité sur la gaufre : 1%

Caractéristiques

- Température : 300 °C à 800 °C
- Pression : de 1×10^{-6} mTorr à 0.1 mTorr
- Réacteur d'épitaxie à simple gaufre muni d'un ensemble d'instruments de mesures in-situ, tels que la diffraction des électrons (RHEED), la spectrométrie de masse (MKS, RGA-MS), et des systèmes de mesures de température par pyrométrie corrigée par réflectivité (Laytec Epi TTR) et la spectroscopie de seuil d'absorption (ABES) et la réflectivité spectroscopique (Laytec).
- Chambre à vide poussé (UHV) munie d'un système de mesure de profils angulaires de flux moléculaires pour la caractérisation d'injecteurs de gaz.

PROCÉDÉS DE ROUTINE

Dépôt de matériaux III-V par épitaxie à jet chimique

- Type de matériaux : tous les III-V à base d'AS et de P
- Épaisseur : 0.1 nm à 10 μ m
- Couplé à une grande capacité de mesure in-situ